

통제번호	개정전		통제번호	개정후	
	국문	영문		국문	영문
1C006 (IL1.C.6)	유체 및 윤활 소재로서 다음의 것:	Fluids and lubricating materials, as follows:	1C006 (IL1.C.6)	유체 및 윤활 소재로서 다음의 것:	Fluids and lubricating materials, as follows:
1C006.a	a. 삭제(Not used since 2015)	a. Not used since 2015;	1C006.a	a. 삭제(Not used since 2015)	a. Not used since 2015;
1C006.b	b. <u>주요 성분으로 다음 중 하나를 함유하는 윤활 소재:</u>	b. Lubricating materials containing, as their principal ingredients, <u>any of the following:</u>	1C006.b	b. <u>윤활 소재의 주요 성분으로서,</u>	b. Lubricating materials containing, as their principal ingredients, <u>any of the following:</u>
<u>1C006.b.1</u>	<u>1. 페닐렌 에테르, 페닐렌 티오-에테르, 알킬페닐렌 에테르, 알킬페닐렌 티오-에테르 또는 이들의 혼합물로서 두개 이상의 에테르(ether) 또는 티오-에테르(ethers) 관능기를 가지고 있거나 이러한 혼합물을 함유한 것; 또는</u>	<u>1. Phenylene or alkylphenylene ethers or thio-ethers, or their mixtures, containing more than two ether or thio-ether functions or mixtures thereof; <u>or</u></u>	<u>1C006.b.1</u>	<u>1. 페닐렌 에테르, 페닐렌 티오-에테르, 알킬페닐렌 에테르, 알킬페닐렌 티오-에테르 또는 이들의 혼합물로서 두개 이상의 에테르(ether) 또는 티오-에테르(ethers) 관능기를 가지고 있거나 이러한 혼합물을 함유한 것; 또는</u>	<u>1. Phenylene or alkylphenylene ethers or thio-ethers, or their mixtures, containing more than two ether or thio-ether functions or mixtures thereof; <u>or</u></u>
<u>1C006.b.2</u>	<u>2. 298 K (25°C) 에서 측정된 동점성 (kinematic viscosity)이 5,000 mm²/s (5,000 centistokes) 미만의 불소계 실리콘액</u>	<u>2. Fluorinated silicone fluids with a kinematic viscosity of less than 5,000 mm²/s (5,000 centistokes) measured at 298 K (25°C);</u>	<u>1C006.b.2</u>	<u><삭제></u>	<u><삭제></u>
1C010.c [민감]	<생략>	c. Inorganic "fibrous or filamentary materials",	1C010.c [민감]	<현행과 동일>	c. Inorganic "fibrous or filamentary materials",

		<p>having all of the following:</p> <p>1. Having any of the following:</p> <p>a. Composed of 50% or more by weight silicon dioxide and having a "specific modulus" exceeding 2.54×10^6 m; or</p> <p>b. Not specified in 1.C.10.c.1.a. and having a "specific modulus" exceeding 5.6×10^6 m; and</p> <p><생략></p>			<p>having all of the following:</p> <p>1. Having any of the following:</p> <p>a. Composed of 50% or more by weight silicon dioxide and having a "specific modulus" exceeding 2.54×10^6 m; or</p> <p>b. Not specified in 1C010.c.1.a. and having a "specific modulus" exceeding 5.6×10^6 m; and</p> <p><생략></p>
1E101 (MT6E.1)	1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115에서 1B119까지, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111에서 1C117 까지, 1D101 또는 1D103에 의해 명시된 물품의 "사용"에 대해 일반기술해설에 규정되어 있는 "기술"	<생략>	1E101 (MT6E.1)	1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115에서 1B119까지, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111에서 1C118 까지, 1D101 또는 1D103에 의해 명시된 물품의 "사용"에 대해 일반기술해설에 규정되어 있는 "기술"	<현행과 동일>
1장 부속서	<생략> <신설> <신설> <신설>	<생략> <신설> <신설> <신설>	1장 부속서	<생략> 50. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide); 51. EDNA (Ethylenedinitramine) (CAS 505-71-5); 52. TKX-50 (Dihydroxylammonium	<생략> 50. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide); 51. EDNA (Ethylenedinitramine) (CAS 505-71-5); 52. TKX-50 (Dihydroxylammonium

<신설>	<신설>	<신설>	2D352	<u>5,5'-bistetrazole-1,1'-diolate</u> 2B352.j에 의해 통제되는 핵산 조립기와 합성기를 위해 설계 된 "소프트웨어"로서 디지털 서 열 데이터에서 기능적 유전 요소를 설계 및 구축할 수 있 는 것	<u>5,5'-bistetrazole-1,1'-diolate</u> "Software" designed for nucleic acid assemblers and synthesizers controlled 2B352.j that is capable of designing and building functional genetic elements from digital sequence data.
2E003 (IL2.E.3) 2E003.a 2E003.b 2E003.b.1 2E003.b.1.a 2E003.b.1.b 2E003.b.1.c 2E003.b.2	다음과 같은 기타의 "기술": a. 삭제 b. 금속의 가공, 제조공정을 위한 "기술"로서 다음의 것: 1. 다음 중 어느 하나의 공 정을 위해 특별히 설계 된 공구, 다이 또는 고 정구의 설계를 위한 "기 술": a. "초소성 성형" (superplastic forming) b. "확산 결합"; 또는 c. '직접작용 (Direct-acting) 유압프 레싱' 2. <u>공정방법이나 공정변수</u> <u>(parameter)로 구성된 기</u> <u>술데이터로 아래 기재된</u> <u>항목을 제어하기 위한</u>	Other "technology", as follows: a. Not used since 2017; b. "Technology" for metal-working manufacturing processes, as follows: 1. "Technology" for the design of tools, dies or fixtures specially designed for any of the following processes: a. "Superplastic forming"; b. "Diffusion bonding"; or c. 'Direct-acting hydraulic pressing'; 2. <u>Technical data consisting</u> <u>of process methods or</u> <u>parameters as listed below</u> <u>used to control:</u>	2E003 (IL2.E.3) 2E003.a 2E003.b 2E003.b.1 2E003.b.1.a 2E003.b.1.b 2E003.b.1.c 2E003.b.2	다음과 같은 기타의 "기술": a. 삭제 b. 금속의 가공, 제조공정을 위한 "기술"로서 다음의 것: 1. 다음 중 어느 하나의 공 정을 위해 특별히 설계 된 공구, 다이 또는 고 정구의 설계를 위한 "기 술": a. "초소성 성형" (superplastic forming) b. "확산 결합"; 또는 c. '직접작용 (Direct-acting) 유압프 레싱' 2. <u>삭제(Not used since</u> <u>2020)</u> <u>주의: 가스터빈 엔진 및 구성</u>	Other "technology", as follows: a. Not used since 2017; b. "Technology" for metal-working manufacturing processes, as follows: 1. "Technology" for the design of tools, dies or fixtures specially designed for any of the following processes: a. "Superplastic forming"; b. "Diffusion bonding"; or c. 'Direct-acting hydraulic pressing'; 2. <u>Not used since 2020</u> <u>N.B. For "technology" for</u>

	<p><u>것:</u></p> <p>a. <u>알루미늄합금, 티타늄합금 또는 "초합금"에 대한 "초소성 성형":</u></p> <p>1. <u>표면 준비</u></p> <p>2. <u>변형율</u></p> <p>3. <u>온도</u></p> <p>4. <u>압력</u></p> <p>b. <u>"초합금" 또는 티타늄합금에 대한 "확산 결합":</u></p> <p>1. <u>표면 준비</u></p> <p>2. <u>온도</u></p> <p>3. <u>압력</u></p> <p>c. <u>알루미늄합금 또는 티타늄합금에 대한 '직접 작용 유압프레스':</u></p> <p>1. <u>압력</u></p> <p>2. <u>사이클 타임(Cycle Time)</u></p> <p>d. <u>티타늄합금, 알루미늄합금 또는 "초합금"의 '열간정수압 고밀화' ('Hot isostatic</u></p>	<p>a. <u>"Superplastic forming" of aluminium alloys, titanium alloys or "superalloys":</u></p> <p>1. <u>Surface preparation;</u></p> <p>2. <u>Strain rate;</u></p> <p>3. <u>Temperature;</u></p> <p>4. <u>Pressure;</u></p> <p>b. <u>"Diffusion bonding" of "superalloys" or titanium alloys:</u></p> <p>1. <u>Surface preparation;</u></p> <p>2. <u>Temperature;</u></p> <p>3. <u>Pressure;</u></p> <p>c. <u>'Direct-acting hydraulic pressing' of aluminium alloys or titanium alloys:</u></p> <p>1. <u>Pressure;</u></p> <p>2. <u>Cycle time;</u></p> <p>d. <u>'Hot isostatic densification' of titanium alloys, aluminium alloys or</u></p>		<p><u>폼금속의 가공, 제조공정을 위한 '기술'은 9E003 및 ML22 참조</u></p>	<p><u>metal-working manufacturing processes for gas turbine engines and components, see 9.E.3. & ML22.</u></p>
--	---	---	--	---	--

	<u>densification</u>): <u>1. 온도</u> <u>2. 압력</u> <u>3. 사이클 타임(Cycle Time)</u> 기술해설: <u>1. '직접작용 유압프레싱'</u> 은 유체가 채워진 신축성 블래더를 사용하여 공작물과 직접 접촉하면서 성형하는 공정을 의미한다. <u>2. '열간정수압 고밀화'</u> 는 <u>375 K (102°C)</u> 를 초과하는 온도에서 폐쇄된 공동(캐비티)에서, 다양한 매질 (기체, 액체, 고체 입자 등)을 통해 주물의 내부 공극을 제거 또는 축소하기 위해 모든 방향에서 동등한 힘을 발생시켜 주물을 가압하는 공정을 의미한다	<u>"superalloys"</u> : <u>1. Temperature;</u> <u>2. Pressure;</u> <u>3. Cycle time;</u> Technical Notes: <u>1. 'Direct-acting hydraulic pressing'</u> is a deformation process which uses a fluid-filled flexible bladder in direct contact with the workpiece. <u>2. 'Hot isostatic densification'</u> is a process of pressurising a casting at temperatures exceeding <u>375 K (102°C)</u> in a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal force in all directions to reduce or eliminate internal voids in the casting.		기술해설: <u>1. '직접작용 유압프레싱'</u> 은 유체가 채워진 신축성 블래더를 사용하여 공작물과 직접 접촉하면서 성형하는 공정을 의미한다. <삭제>	Technical Notes: <u>1. 'Direct-acting hydraulic pressing'</u> is a deformation process which uses a fluid-filled flexible bladder in direct contact with the workpiece. <삭제>
2E201	2A225, 2A226, 2B001, 2B006,	<생략>	2E201	2A225, 2A226, 2B001, 2B006,	<현행과 같음>

(NR)	2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B2255 에서 2B233, 2D201 또는 2D202에 기술된 장비의 "사용" 또는 " 소프트웨어 "를 위한 기술제어에 적용되는 일반 기술 해설에 따른 "기술"		(NR)	2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 에서 2B233, 2D201 또는 2D202에 기술된 장비의 "사용" 또는 " 소프트웨어 " "사용"에 대한 일반 기술 해설에 따른 "기술"	
표-주	<생략>	TABLE - DEPOSITION TECHNIQUES - NOTES <생략> 10. Category 2 does not include "technology" for single-step pack cementation of solid airfoils	표-주	<현행과 같음>	TABLE - DEPOSITION TECHNIQUES - NOTES <생략> 10. Category 2 does not include "technology" for single-step pack cementation of solid acrofoils
3A	제3부 전자 시스템, 장비 및 구성품 주 1: 3A001~3A003의 장비 및 구성품의 통제여부는 (3A001.a.3~10항 또는 3A001.a.12~14항 에 기술된 것은 제외) 다른 장비와 동일한 기능적 특성을 갖거나 그것을 위해 전용 설계된 것이	CATEGORY 3 - ELECTRONICS Systems, Equipment and Components Note 1: The control status of equipment and components described in 3A001 to 3A003, other than those described in 3A001.a.3. to 3A001.a.10., or	3A	제3부 전자 시스템, 장비 및 구성품 주 1: 3A001~3A003의 장비 및 구성품의 통제여부는 (3A001.a.3~10항 또는 3A001.a.12~14항 , 또는 3A001.b.12항 에 기술된 것은 제외) 다른 장비와 동일한 기능적 특성을 갖거나 그것을 위	CATEGORY 3 - ELECTRONICS Systems, Equipment and Components Note 1: The control status of equipment and components described in 3A001 to 3A003, other than those described in 3A001.a.3. to 3A001.a.10., or

	면 그 다른 장비의 통제여부에 의해 결정된다.	3A001.a.12. to 3A001.a.14. , which are specially designed for or which have the same functional characteristics as other equipment is determined by the status of the other equipment.		해 전용 설계된 것이면 그 다른 장비의 통제여부에 의해 결정된다.	3A001.a.12. to 3A001.a.14. , or 3A001b.12. which are specially designed for or which have the same functional characteristics as other equipment is determined by the status of the other equipment.
3A001.b.4.b.1	1. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 8.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 70 W (48.54 dBm)를 초과하는 것	1. A peak saturated power output greater than 70 W (48.54 dBm) at any frequency exceeding 6.8 GHz up to and including 8.5 GHz;	3A001.b.4.b.1	1. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 8.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 70 W (48.45 dBm)를 초과하는 것	1. A peak saturated power output greater than 70 W (48.45 dBm) at any frequency exceeding 6.8 GHz up to and including 8.5 GHz;
3A001.b.11.e	e. 37 GHz 초과 90 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μ s 미만인 것; 또는	e. Less than 100 μ s for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the synthesised frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding 90 GHz ; or	3A001.b.11.e	e. 37 GHz 초과 75 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μ s 미만인 것; 또는	e. Less than 100 μ s for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the synthesised frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding 75 GHz ; or
3A001.b.11.f	f. 삭제(Not used since 2016)	f. Not used since 2016	3A001.b.11.f	f. 75 GHz 초과 90 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 5.0 GHz 를 초과하는 주파	f. Less than 100 μs for any frequency change exceeding 5.0 GHz within the synthesised frequency

				<u>수 변화에 대해 100 μs 미만인 것; 또는</u>	<u>range exceeding 75 GHz but not exceeding 90 GHz; or</u>
3A001.e.1	<생략> 주: <u>3A001.e.1</u> 는 축전지 (battery)(단일 셀 축전지를 포함)는 통제하지 않는다.	<생략>		<생략> 주: <u>3A001.e.1</u> 는 축전지 (battery)(단일 셀 축전지를 포함)는 통제하지 않는다.	<현행과 같음>
3A002.c.2	<생략>	2. "Signal analysers" having <u>Displayed</u> Average Noise Level (DANL) less (better) than -150 dBm/Hz anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz;	3A002.c.2	<현행과 같음>	2. "Signal analysers" having <u>a Displayed</u> Average Noise Level (DANL) less (better) than -150 dBm/Hz anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz;
3A002.d.3.d	d. 31.8 GHz 초과 37 GHz 이하의 주파수 범위 내에서 550 MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 500 μ s 미만인 것; <u>또는</u>	d. Less than 500 μ s for any frequency change exceeding 550 MHz within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; <u>or</u>	3A002.d.3.d	d. 31.8 GHz 초과 37 GHz 이하의 주파수 범위 내에서 550 MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 500 μ s 미만인 것; <u>또는</u>	d. Less than 500 μ s for any frequency change exceeding 550 MHz within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; <u>or</u>
3A002.d.3.e	e. 37 GHz 초과 <u>90 GHz</u> 이하의 주파수 범위 내에서 2.2 MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μ s 미만인 <u>것</u> ;	e. Less than 100 μ s for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding <u>90 GHz</u> ;	3A002.d.3.e	e. 37 GHz 초과 <u>75 GHz</u> 이하의 주파수 범위 내에서 2.2 MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μ s 미만인 <u>것</u> ; <u>또는</u>	e. Less than 100 μ s for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding <u>75 GHz</u> ; <u>or</u>

<신설>	<신설>		3A002.d.3.g	g. 75 GHz 초과 90GHz 이하의 주파수 범위 내에서 5.0 GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μ s 미만인 것;	g. Less than 100 μ s for any frequency change exceeding 5.0 GHz within the frequency range exceeding 75 GHz but not exceeding 90 GHz.
3A002.d.4	<생략>	4. <u>Single</u> sideband (SSB) phase noise, in dBc/Hz, specified as being any of the following:	3A002.d.4	<현행과 동일>	4. <u>A single</u> sideband (SSB) phase noise, in dBc/Hz, specified as being any of the following:
3A002.d.5	<p>5. 디지털 기저대역 신호들의 'RF 변조 대역폭'이 다음 중 하나인 것:</p> <p>a. 4.8 GHz 초과 31.8 GHz 이하인 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 것</p> <p>b. 31.8 GHz 초과 37 GHz 이하인 주파수 범위 내에서 550 MHz를 초과하는 것; 또는</p> <p>c. 37 GHz 초과 <u>90 GHz</u> 이하인 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 것; 또는</p>	<p>5. An 'RF modulation bandwidth' of digital baseband signals as specified in any of the following:</p> <p>a. Exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 4.8 GHz but not exceeding 31.8 GHz;</p> <p>b. Exceeding 550 MHz within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; or</p> <p>c. Exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding</p>	3A002.d.5	<p>5. 디지털 기저대역 신호들의 'RF 변조 대역폭'이 다음 중 하나인 것:</p> <p>a. 4.8 GHz 초과 31.8 GHz 이하인 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 것</p> <p>b. 31.8 GHz 초과 37 GHz 이하인 주파수 범위 내에서 550 MHz를 초과하는 것; 또는</p> <p>c. 37 GHz 초과 <u>75 GHz</u> 이하인 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 것; 또는</p>	<p>5. An 'RF modulation bandwidth' of digital baseband signals as specified in any of the following:</p> <p>a. Exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 4.8 GHz but not exceeding 31.8 GHz;</p> <p>b. Exceeding 550 MHz within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; or</p> <p>c. Exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding</p>

	<신설>	90 GHz; or <신설>		d. 75 GHz 초과 90 GHz 이하인 주파수 범위 내 에서 5.0 GHz를 초과 하는 것; 또는	75 GHz; or d. Exceeding 5.0 GHz within the frequency range exceeding 75 GHz but not exceeding 90 GHz; or
3C001 (IL3.C.1.)	다음 중 하나에 해당하는 소 재의 다층막(multiple layer)으 로 된 헤테로 적층 (hetero-epitaxial) 결정을 가지 는 "기판"(substrate):	Hetero-epitaxial materials consisting of a "substrate" having stacked epitaxially grown multiple layers of any of the following:	3C001 (IL3.C.1.)	다음 중 하나에 해당하는 소 재의 다층막(multiple layer)으 로 된 헤테로 적층 (hetero-epitaxial) 결정을 가지 는 "기판"(substrate):	Hetero-epitaxial materials consisting of a "substrate" having stacked epitaxially grown multiple layers of any of the following:
3C001.a	a. 실리콘 (Si)	a. Silicon (Si);	3C001.a	a. 실리콘 (Si)	a. Silicon (Si);
3C001.b	b. 게르마늄 (Ge)	b. Germanium (Ge);	3C001.b	b. 게르마늄 (Ge)	b. Germanium (Ge);
3C001.c	c. 실리콘 카바이드 (SiC); <u>또 는</u>	c. Silicon carbide (SiC); <u>or</u>	3C001.c	c. 실리콘 카바이드 (SiC); <u>또 는</u>	c. Silicon carbide (SiC); <u>or</u>
3C001.d	d. 갈륨(Ga) 또는 인듐(In)의 "III/V족 화합물"	d. "III/V compounds" of gallium or indium.	3C001.d	d. 갈륨(Ga) 또는 인듐(In)의 "III/V족 화합물"	d. "III/V compounds" of gallium or indium;
<신설>	<신설>	<신설>	<u>3C001.e</u>	<u>e. 갈륨 옥사이드 (Ga₂O₃); 또 는</u>	<u>e. Gallium Oxide (Ga₂O₃); or</u>
<신설>	<신설>	<신설>	<u>3C001.f</u>	<u>f. 다이아몬드;</u>	<u>f. Diamond;</u>
3C005.a	a. 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루 미늄 나이트라이드(AIN) <u>또는 알루미늄 갈륨 나 이트라이드(AlGaN)</u> 반도체 " 기판", 주괴(ingots), 불 (boules) 또는 이러한 재료 로 만든 기타 모재 (preforms)로서 20 °C에서 10,000 ohm-cm보다 큰 저	a. Silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminium nitride (AlN) <u>or</u> <u>aluminium gallium nitride</u> <u>(AlGaN)</u> semiconductor "substrates", or ingots, boules, or other preforms of those materials, having resistivities greater than 10,000 ohm-cm at 20°C;	3C005.a	a. 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루 미늄 나이트라이드(AIN), <u>또는 알루미늄 갈륨 나 이트라이드(AlGaN), 갈륨 옥 사이드 (Ga₂O₃) 또는 다이 아몬드</u> 반도체 "기판", 주 괴(ingots), 불(boules) 또는 이러한 재료로 만든 기타 모재(preforms)로서 20 °C	a. Silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminium nitride (AlN) <u>or</u> <u>aluminium gallium nitride</u> <u>(AlGaN), gallium oxide</u> <u>(Ga₂O₃) or diamond</u> semiconductor "substrates", or ingots, boules, or other preforms of those materials, having resistivities greater

	항을 가지는 것			에서 10,000 ohm-cm보다 큰 저항을 가지는 것	than 10,000 ohm-cm at 20°C;
3C005.b	b. 20°C에서 10,000 ohm-cm 보다 큰 저항을 가지는 다결정 "기판" 또는 다결정 세라믹 "기판", 그리고 그 "기판"의 표면에 적어도 한 개의 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드 (AlN) 또는 <u>알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN)</u> 비에 피택셀 단결정 층을 갖는 다결정 "기판" 또는 다결정 세라믹 "기판"	b. Polycrystalline "substrates" or polycrystalline ceramic "substrates", having resistivities greater than 10,000 ohm-cm at 20°C and having at least one non-epitaxial single-crystal layer of silicon (Si), silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminium nitride (AlN), <u>or aluminium gallium nitride (AlGaN)</u> on the surface of the "substrate".	3C005.b	b. 20°C에서 10,000 ohm-cm 보다 큰 저항을 가지는 다결정 "기판" 또는 다결정 세라믹 "기판", 그리고 그 "기판"의 표면에 적어도 한 개의 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드 (AlN), 또는 알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN), 갈륨 옥사이드 (Ga₂O₃) 또는 다이아몬드 비에 피택셀 단결정 층을 갖는 다결정 "기판" 또는 다결정 세라믹 "기판"	b. Polycrystalline "substrates" or polycrystalline ceramic "substrates", having resistivities greater than 10,000 ohm-cm at 20°C and having at least one non-epitaxial single-crystal layer of silicon (Si), silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminium nitride (AlN), <u>or aluminium gallium nitride (AlGaN), gallium oxide (Ga₂O₃) or diamond</u> on the surface of the "substrate".
3C006 (IL3.C.6.)	3C005에서 규정된 "기판"이나 3C001에서 명시되지 않은 것으로서 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드(AlN) 또는 <u>알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN)</u> 로 된 한층 이상의 에피택셀층을 갖는 것	Materials, not specified in 3C001., consisting of a "substrate" specified in 3C005. with at least one epitaxial layer of silicon carbide, gallium nitride, aluminium nitride <u>or aluminium gallium nitride.</u>	3C006 (IL3.C.6.)	3C005에서 규정된 "기판"이나 3C001에서 명시되지 않은 것으로서 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드(AlN), 또는 알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN), 갈륨 옥사이드 (Ga₂O₃) 또는 다이아몬드 로 된 한층 이상의 에피택셀층을 갖는 것	Materials, not specified in 3C001., consisting of a "substrate" specified in 3C005. with at least one epitaxial layer of silicon carbide, gallium nitride, aluminium nitride <u>or aluminium gallium nitride, gallium oxide (Ga₂O₃) or diamond.</u>
<신설>	<신설>	<신설>	3D006 (IL3.D.6.)	" <u>게이트올어라운드 전계 효과 트랜지스터("GAAFET")</u> " 구조를 갖고 집적회로의 "개발"을	' <u>Electronic Computer-Aided Design</u> ' ('ECAD') " <u>software</u> " <u>specifically designed for the</u>

<p><신설></p>	<p><신설></p>	<p><신설></p>	<p>3D006.a (IL3.D.6.a)</p>	<p>위해 전용 설계된 '전자 CAD (ECAD)' "소프트웨어"로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것;</p> <p>a. '기하학적 데이터베이스 표준 II'('GDSII') 또는 이에 상응하는 표준으로 '레지스터 전송 레벨 (RTL)'을 구현하기 위해 전용 설계된 것; 또는</p>	<p>"development" of integrated circuits having any "Gate-All-Around Field-Effect Transistor" ("GAAFET") structure, and having any of the following:</p> <p>a. Specially designed for implementing 'Register Transfer Level' ('RTL') to 'Geometrical Database Standard II' ('GDSII') or equivalent standard; or</p>
<p><신설></p>	<p><신설></p>	<p><신설></p>	<p>3D006.b (IL3.D.6.b)</p>	<p>b. 전력이나 타이밍 규칙을 최적화하기 위해 전용설계된 것.</p> <p><u>기술해설:</u></p> <p>1. '전자 CAD' ('ECAD')는 집적회로 또는 인쇄 회로 기판의 성능을 설계, 분석, 최적화, 그리고 검증하기 위해 사용되는 "소프트웨어" 툴의 한 종류이다.</p> <p>2. '레지스터 전송 레벨'(RTL)은 하드웨어 레지스터 간의 디지털 신호 흐름과 그 신호들에 대해 수행되는 논리 연산 측면</p>	<p>b. Specially designed for optimisation of power or timing rules.</p> <p><u>Technical Notes</u></p> <p>1. 'Electronic Computer-Aided Design' ('ECAD') is a category of "software" tools used for designing, analysing, optimising, and validating the performance of integrated circuit or printed circuit board.</p> <p>2. 'Register Transfer Level' ('RTL') is a design abstraction which models a synchronous digital circuit</p>

				에서 동기식 디지털 회로를 모델링하는 설계 추상화이다.	<i>in terms of the flow of digital signals between hardware registers, and the logical operations performed on those signals.</i>
				3. '기하학적 데이터베이스 표준 II' ('GDSII')는 집적 회로 또는 집적 회로 레이아웃 아트 워크의 데이터 교환을 위한 데이터베이스 파일 형식이다.	3. <i>'Geometrical Database Standard II' ('GDSII') is a database file format for data exchange of integrated circuit or integrated circuit layout artwork.</i>
3E003.d	d. 전자 구성품용 <u>다이아몬드 막</u> 회로기판(substrate)	d. Substrates of <u>films of diamond</u> for electronic components.	3E003.d	d. 전자 구성품용 <u>다이아몬드 막</u> 회로기판(substrate)	d. Substrates of <u>films of diamond</u> for electronic components.
<신설>	<신설>	<신설>	3E003.h	<u>h. 전자 구성품용 갈륨 옥사이드 회로기판(substrate)</u>	<u>h. Substrates of gallium oxide for electronic components.</u>
4A003.b	b. '최적수행성능'(Adjusted Peak Performance, 'APP')이 <u>29 Weighted TeraFLOPS(WT)</u> 를 초과하는 "디지털 컴퓨터"	b. "Digital computers" having an 'Adjusted Peak Performance' ('APP') exceeding <u>29 Weighted TeraFLOPS (WT)</u> ;	4A003.b	b. '최적수행성능'(Adjusted Peak Performance, 'APP')이 <u>70.0 Weighted TeraFLOPS(WT)</u> 를 초과하는 "디지털 컴퓨터"	b. "Digital computers" having an 'Adjusted Peak Performance' ('APP') exceeding <u>70.0 Weighted TeraFLOPS (WT)</u> ;
4D001.a (IL4.D.1)	a. <u>상기 4A001 또는 4D001</u> 에 의해 통제되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"	a. "Software" specially designed or modified for the "development" or "production" of equipment or "software" specified in <u>4A001 or 4D001.</u>	4D001.a (IL4.D.1)	a. <u>상기 4A001에서 4A005 또는 4D</u> 에 의해 통제되는 장비 또는 "소프트웨어"의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"	a. "Software" specially designed or modified for the "development" or "production" of equipment or "software" specified in <u>4A001 to 4A005, or 4D.</u>
5A001.f.4	4. 5A001.f.1, 5A001.f.2 또는 5A001.f.3에 명시된 품목의 작동을 확인하기 위	4. RF monitoring equipment designed or modified to identify the operation of	5A001.f.4	4. 5A001.f.1, 5A001.f.2 또는 5A001.f.3에 명시된 품목의 작동을 확인하기 위	4. RF monitoring equipment designed or modified to identify the operation of

	<p>해 설계되거나 개조된 RF 감시 장치</p> <p>주: <u>5A001.f.1</u>과 <u>5A001.f.2</u>는 다음은 통제하지 않는다:</p> <p><생략></p>	<p>items specified in 5A001.f.1, 5A001.f.2 or 5A001.f.3;</p> <p>Note: <u>5A001.f.1</u> and <u>5A001.f.2</u> do not control any of the following:</p> <p><생략></p>		<p>해 설계되거나 개조된 RF 감시 장치</p> <p>주: <u>5A001.f.1</u>과 <u>5A001.f.2</u>는 다음은 통제하지 않는다:</p> <p><생략></p>	<p>items specified in 5A001.f.1, 5A001.f.2 or 5A001.f.3;</p> <p>Note: <u>5A001.f.1</u> and <u>5A001.f.2</u> do not control any of the following:</p> <p><생략></p>
5A003.a	<p>a. 부정한 침입을 탐지하기 위해 기계적, 전기적 혹은 전자적인 <u>방법으로</u> 설계되거나 개조된 통신케이블 시스템</p>	<p>a. Communications cable systems designed or modified <u>using</u> mechanical, electrical or electronic means to detect surreptitious intrusion;</p>	5A003.a	<p>a. 부정한 침입을 탐지하기 위해 기계적, 전기적 혹은 전자적인 <u>방법을 사용하기 위해</u> 설계되거나 개조된 통신케이블 시스템</p>	<p>a. Communications cable systems designed or modified <u>to use</u> mechanical, electrical or electronic means to detect surreptitious intrusion;</p>
6A002.a.1.c [민감]	<p>c. "우주용" <u>반도체</u> 검출기로서 1,200nm 초과 ~ 30,000 nm 이하의 파장에서 최대응답을 갖는 것</p>	<생략>	6A002.a.1.c [초민감] [민감]	<p>c. "우주용" <u>고체상태</u> 검출기로서 1,200nm 초과 ~ 30,000 nm 이하의 파장에서 최대응답을 갖는 것</p>	<현행과 같음>
6A005.d.1.b.1	<p>1. 파장이 1,400 nm 미만이고 평균 CW 출력이 <u>15 W</u>를 초과하는 것</p>	<p>1. Wavelength of less than 1,400 nm and average or CW output power, exceeding <u>15 W</u>;</p>	6A005.d.1.b	<p>1. 파장이 1,400 nm 미만이고 평균 CW 출력이 <u>25 W</u>를 초과하는 것</p>	<p>1. Wavelength of less than 1,400 nm and average or CW output power, exceeding <u>25 W</u>;</p>
6A008.1 6A008.1.1	<p>1. 데이터처리 서브시스템(sub system)으로서 다음 중 하나의 것:</p> <p>1. '자동표적추적' 기술로, 안테나 회전 중에 다음 안테나 빔 통과시간보다</p>	<p>1. Having data processing sub-systems with any of the following:</p> <p>1. 'Automatic target tracking' providing, at any antenna rotation, the predicted</p>	6A008.1 6A008.1.1	<p>1. 데이터처리 서브시스템(sub system)으로서 다음 중 하나의 것:</p> <p>1. '자동표적추적' 기술로, 안테나 회전 중에 다음 안테나 빔 통과시간보다</p>	<p>1. Having data processing sub-systems with any of the following:</p> <p>1. 'Automatic target tracking' providing, at any antenna rotation, the predicted</p>

	<p>먼저 표적 위치를 예견하는 것; 또는</p> <p>주: 6A008.1.1은 ATC 시스템에서의 충돌경보기 능이나, 해상용 레이더는 통제하지 않는다.</p> <p>기술해설: '자동 표적 추적'은 실시간으로 표적의 가장 가능한 위치의 추정 값을 자동으로 결정하여 제공하는 처리 기술이다.</p>	<p>target position beyond the time of the next antenna beam passage; or</p> <p>Note: 6A008.1.1. does not control conflict alert capability in ATC systems, or 'marine radar'.</p> <p>Technical Note: 'Automatic target tracking' is a processing technique that automatically determines and provides as output an extrapolated value of the most probable position of the target in real time.</p>		<p>먼저 표적 위치를 예견하는 것; 또는</p> <p>주: 6A008.1.1은 ATC 시스템에서의 충돌경보기 능이나, 해상용 레이더는 통제하지 않는다.</p> <p>기술해설: '자동 표적 추적'은 실시간으로 표적의 가장 가능한 위치의 추정 값을 자동으로 결정하여 제공하는 처리 기술이다.</p>	<p>target position beyond the time of the next antenna beam passage; or</p> <p>Note: 6A008.1.1. does not control conflict alert capability in ATC systems, or 'marine radar'.</p> <p>Technical Note: 'Automatic target tracking' is a processing technique that automatically determines and provides as output an extrapolated value of the most probable position of the target in real time.</p>
6A008.1.2	2. 삭제	2. Not used	6A008.1.2	2. 삭제	2. Not used
6A008.1.3	3. 삭제	3. Not used	6A008.1.3	3. 삭제	3. Not used
6A008.1.4	4. 6A008.f 나 혹은 6A008.i 에서 규정된 단위 센서의 특성 이상으로 종합적인 성능을 향상할 목적으로 6초안에 2개 이상의 '지	4. Configured to provide superposition and correlation, or fusion, of target data within six seconds from two or more	6A008.1.4	4. 6A008.f 나 혹은 6A008.i 에서 규정된 단위 센서의 특성 이상으로 종합적인 성능을 향상할 목적으로 6초안에 2개 이상의 '지	4. Configured to provide superposition and correlation, or fusion, of target data within six seconds from two or more

	<p>리적으로 분산'되고 "상호 연결된 레이더 센서"로부터의 표적 데이터를 표적강화와 식별을 목적으로 중첩(superposition)하고 상호 관련(correlation)시키는 것 혹은 융합(fusion) 시키도록 구성된 것.</p> <p>기술해설: 센서는 각 위치가 어떤 방향으로든 1,500 m 이상 떨어져 있을 때 '지리적으로 분산'된 것으로 간주된다. 모바일 센서는 항상 '지리적으로 분산'된 것으로 간주된다.</p> <p>주의: ML5.b 참조</p> <p>주: 6A008.1은 '해양 교통 관제제도'에 사용되는 시스템, 장비, 조립품은 통제하지 않는다.</p> <p>기술해설:</p>	<p>'geographically dispersed' radar sensors to improve the aggregate performance beyond that of any single sensor specified in 6A008.f. or 6A008.i.</p> <p><i>Technical Note:</i> <i>Sensors are considered 'geographically dispersed' when each location is distant from any other more than 1,500 m in any direction. Mobile sensors are always considered 'geographically dispersed'.</i> N.B. See also ML5.b.</p> <p><i>Note:</i> 6A008.1 does not control systems, equipment and assemblies <u>used</u> for 'vessel traffic services'.</p> <p><i>Technical Notes:</i></p>		<p>리적으로 분산'되고 "상호 연결된 레이더 센서"로부터의 표적 데이터를 표적강화와 식별을 목적으로 중첩(superposition)하고 상호 관련(correlation)시키는 것 혹은 융합(fusion) 시키도록 구성된 것.</p> <p>기술해설: 센서는 각 위치가 어떤 방향으로든 1,500 m 이상 떨어져 있을 때 '지리적으로 분산'된 것으로 간주된다. 모바일 센서는 항상 '지리적으로 분산'된 것으로 간주된다.</p> <p>주의: ML5.b 참조</p> <p>주: 6A008.1은 '해양 교통 관제제도'를 위해 설계된 시스템, 장비, 조립품은 통제하지 않는다.</p> <p>기술해설:</p>	<p>'geographically dispersed' radar sensors to improve the aggregate performance beyond that of any single sensor specified in 6A008.f. or 6A008.i.</p> <p><i>Technical Note:</i> <i>Sensors are considered 'geographically dispersed' when each location is distant from any other more than 1,500 m in any direction. Mobile sensors are always considered 'geographically dispersed'.</i> N.B. See also ML5.b.</p> <p><i>Note:</i> 6A008.1 does not control systems, equipment and assemblies <u>designed</u> for 'vessel traffic services'.</p> <p><i>Technical Notes:</i></p>
--	--	--	--	--	--

	<p>1. 6A008의 통제를 위한 '해양 레이더'는 근해나 내륙 수로나 혹은 바다에서 안전 <u>항해용으로 사용되는</u> 레이더이다.</p> <p>2. 6A008의 통제를 위한 '해양 교통 관제제도'는 "항공기"의 항공 교통 관제와 비슷하게 해양 교통을 감시 및 통제하는 것이다.</p>	<p>1. For the purposes of 6A008, 'marine radar' is a radar that is <u>used</u> to navigate safely at sea, inland waterways or near-shore environments.</p> <p>2. For the purposes of 6A008, 'vessel traffic service' is a vessel traffic monitoring and control service similar to air traffic control for "aircraft".</p>		<p>1. 6A008의 통제를 위한 '해양 레이더'는 근해나 내륙 수로나 혹은 바다에서 안전 <u>항해용으로 설계된</u> 레이더이다.</p> <p>2. 6A008의 통제를 위한 '해양 교통 관제제도'는 "항공기"의 항공 교통 관제와 비슷하게 해양 교통을 감시 및 통제하는 것이다.</p>	<p>1. For the purposes of 6A008, 'marine radar' is a radar that is <u>designed</u> to navigate safely at sea, inland waterways or near-shore environments.</p> <p>2. For the purposes of 6A008, 'vessel traffic service' is a vessel traffic monitoring and control service similar to air traffic control for "aircraft".</p>
6D003.h.1	<p>1. 4개 이상의 주 레이더로부터 포적 레이더 데이터를 수용할 수 있고 항공 교통통제센터에 위치한 범용 컴퓨터에 탑재되도록 설계된 항공교통통제(ATC) "소프트웨어" <u>응용 프로그램</u>;</p>	<p>1. Air Traffic Control (ATC) "software" <u>application "programs"</u> designed to be hosted on general purpose computers located at Air Traffic Control centres and capable of accepting radar target data from more than four primary radars;</p>	6D003.h.1	<p>1. 4개 이상의 주 레이더로부터 포적 레이더 데이터를 수용할 수 있고 항공 교통통제센터에 위치한 범용 컴퓨터에 탑재되도록 설계된 항공교통통제(ATC) "소프트웨어" <u>응용 프로그램</u>;</p>	<p>1. Air Traffic Control (ATC) "software" <u>application "programs"</u> designed to be hosted on general purpose computers located at Air Traffic Control centres and capable of accepting radar target data from more than four primary radars;</p>
7E004.c.3	<생략>	<p>3. Rotor blades incorporating 'variable geometry <u>airfoils</u>', for use in systems using individual blade control.</p> <p><i>Technical Note:</i> <i>'Variable geometry</i></p>	7E004.c.3	<현행과 같음>	<p>3. Rotor blades incorporating 'variable geometry <u>aerofoils</u>', for use in systems using individual blade control.</p> <p><i>Technical Note:</i> <i>'Variable geometry</i></p>

		<i>airfoils' use trailing edge flaps or tabs, or leading edge slats or pivoted nose droop, the position of which can be controlled in flight.</i>			<i>aerofoils' use trailing edge flaps or tabs, or leading edge slats or pivoted nose droop, the position of which can be controlled in flight.</i>
9A004 (IL9.A.4) (MT1.A.1) (MT19.A.1)	우주발사체, "우주비행체", "우주비행체 버스(buses)", "우주비행체 탑재체(payloads)", "우주비행체" 탑재 시스템 또는 장비, 지상파(terrestrial) 장비 <u>그리고 공중발사 플랫폼으로서</u> 다음의 것:	Space launch vehicles, "spacecraft", "spacecraft buses", "spacecraft payloads", "spacecraft" on-board systems or equipment, terrestrial equipment, and <u>air-launch platforms</u> , as follows:	9A004 (IL9.A.4) (MT1.A.1) (MT19.A.1)	우주발사체, "우주비행체", "우주비행체 버스(buses)", "우주비행체 탑재체(payloads)", "우주비행체" 탑재 시스템 또는 장비, 지상파(terrestrial) 장비 <u>그리고 공중발사 플랫폼 그리고 "준궤도 비행체"로서</u> 다음의 것:	Space launch vehicles, "spacecraft", "spacecraft buses", "spacecraft payloads", "spacecraft" on-board systems or equipment, terrestrial equipment, and <u>air-launch platforms and "sub-orbital craft"</u> , as follows:
	주의: 9A104 참조	N.B. SEE ALSO 9A104.		주의: 9A104 참조	N.B. SEE ALSO 9A104.
9A004.g	g. <u>우주발사체</u> 를 위한 공중발사 플랫폼으로 전용 설계되거나 개조된 "항공기"	g. "Aircraft" specially designed or modified to be air-launch platforms for <u>space launch vehicles</u> .	9A004.g	g. <u>우주발사체 또는 "준궤도 비행체"</u> 를 위한 공중발사 플랫폼으로 전용 설계되거나 개조된 "항공기"	g. "Aircraft" specially designed or modified to be air-launch platforms for <u>space launch vehicles or "sub-orbital craft"</u> .
9B001.c	c. <u>가스터빈 엔진 블레이드, 베인(vanes) 또는 "팁 슈라우드"의 제작을 위해 전용 설계된</u> 방향성 고품화 혹은 단결정 적층 생산장비	c. Directional-solidification or single-crystal additive-manufacturing equipment, <u>specially designed for manufacturing gas turbine engine blades, vanes or "tip shrouds"</u> .	9B001.c	c. <u>"초합금"을 위해 전용 설계된</u> 방향성 고품화 혹은 단결정 적층 생산장비	c. Directional-solidification or single-crystal additive-manufacturing equipment, <u>designed for "superalloys"</u> .
9B004 (IL9.B.4)	<생략>	Tools, dies or fixtures, for the solid state joining of	9B004 (IL9.B.4)	<현행과 같음>	Tools, dies or fixtures, for the solid state joining of

		"superalloy", titanium or intermetallic <u>airfoil</u> -to-disk combinations described in 9E003.a.3. or 9E003.a.6. for gas turbines.			"superalloy", titanium or intermetallic <u>aerofoil</u> -to-disk combinations described in 9E003.a.3. or 9E003.a.6. for gas turbines.
<신설>	<신설>	<신설>	9E003.a.2.e	e. 압력 증가 연소(<u>pressure gain combustion</u>)를 활용 <u>기술해설:</u> <u>'압력 증가 연소'에서 엔진이 "정상 상태 모드"에서 작동할 때 연소기 출구의 벌크 평균 정체 압력은 주로 연소 과정으로 인한 연소기 입구의 벌크 평균 정체 압력보다 크다.</u>	e. Utilising ' <u>pressure gain combustion</u> '; <u>Technical Note:</u> <u>In 'pressure gain combustion' the bulk average stagnation pressure at the combustor outlet is greater than the bulk average stagnation pressure at the combustor inlet due primarily to the combustion process, when the engine is running in a "steady state mode" of operation.</u>
9E003.a.4 [민감]	<생략>	4. Uncooled turbine blades, vanes or "tip-shrouds", designed to operate at a 'gas path temperature' of 1,373 K (1,100°C) or more;	9E003.a.4 [민감]	<현행과 동일>	4. Uncooled turbine blades, vanes or "tip-shrouds", designed to operate at a 'gas path temperature' of 1,373 K (1,100°C) or more;
9E003.a.5 [민감]	<생략>	5. Cooled turbine blades, vanes, "tip-shrouds" other than those described in 9E003.a.1,	9E003.a.5 [민감]	<현행과 동일>	5. Cooled turbine blades, vanes, "tip-shrouds" other than those described in 9E003.a.1, designed to

		designed to operate at a 'gas path temperature' of 1,693 K (1,420°C) or more;			operate at a 'gas path temperature' of 1,693 K (1,420°C) or more;
9E003.a.6	<생략>	6. <u>Airfoil-to-disk</u> blade combinations using solid state joining;	9E003.a.6	<현행과 동일>	6. <u>Aerofoil-to-disk</u> blade combinations using solid state joining;
<u>0B001.b.2</u>	<u>2. 회전자 조립체</u>	<u>2. Rotating components</u>	<u>0B001.b.2</u>	<u>[회전부품]</u> <u>2. 회전자 조립체</u>	<u>[Rotating components]</u> <u>2. Complete rotor assemblies:</u>
<u>0B001.b.7</u> <u>(NT5.1.2. a~f)</u>	<u>7. 고정부품</u>	<u>7. Static components</u>	<u>0B001.b.7</u> <u>(NT5.1.2. a~f)</u>	<u>[고정부품]</u> <u>7. 자기 지지 베어링</u>	<u>[Static components]</u> <u>7. Magnetic suspension bearings:</u>
0B002 (NT5.2) (NT5.4)	<생략> 주) <u>상기</u> 품목은 육불화우라늄(UF ₆) 공정 가스와 직접적으로 <u>연결되거나</u> 원심분리기에서 원심분리기까지 그리고 캐스케이드에서 캐스케이드까지의 가스 배관 및 원심분리기를 직접 통제한다. UF ₆ 에 내부식성을 갖는 재질에는 동, 동합금, 스테인레스강, 알루미늄, 산화알루미늄, 알루미늄합금, 니켈, 또는 60%이상의 니켈합금	<생략>	0B002 (NT5.2) (NT5.4)	<생략> 주) <u>다음</u> 품목은 육불화우라늄(UF ₆) 공정 가스와 직접적으로 <u>맞닿아 있거나</u> 원심분리기에서 원심분리기까지 그리고 캐스케이드에서 캐스케이드까지의 가스 배관 및 원심분리기를 직접 통제한다. UF ₆ 에 내부식성을 갖는 재질에는 동, 동합금, 스테인레스강, 알루미늄, 산화알루미늄, 알루미늄합금, 니켈, 또는 60%이상의 니켈합금	<현행과 같음>

	및 불화 탄화수소중합체 등이 있다.			및 불화 탄화수소중합체 등이 있다.	
0B003 (NT7.1)	우라늄 변환공장 및 그 용도로 특별히 <u>설계된</u> 계통	<생략>	0B003 (NT7.1)	우라늄 변환공장 및 그 용도로 특별히 <u>설계되거나 준비된</u> 계통	<현행과 동일>
0B003.a	a. 우라늄정광을 UO_3 로 변환하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 계통 주) 우라늄 정광을 UO_3 로 변환하기 위해서는 질산에 광석을 용해시키고 트리뷰틸 인산염과 같은 용매를 사용하여 정제된 우라닐 질산염을 추출한다. <u>우라닐 질산염을 농축</u> 및 탈질산 과정을 거치거나, 혹은 가스상태의 암모니아로 중화하여 여과, 건조, 하소하여 중우라늄산 암모늄 생성 후 UO_3 로 변환된다.	<생략>	0B003.a	a. 우라늄정광을 UO_3 로 변환하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 계통 주) 우라늄 정광을 UO_3 로 변환하기 위해서는 질산에 광석을 용해시키고 트리뷰틸 인산염과 같은 용매를 사용하여 정제된 우라닐 질산염을 추출한다. <u>추출된 우라닐 질산염은 농집</u> 및 탈질산과정을 거치거나, 혹은 가스상태의 암모니아로 중화하여 여과, 건조, 하소하여 중우라늄산 암모늄 생성 후 UO_3 로 변환된다.	<현행과 동일>
0B003.e	e. UF_4 를 UF_6 로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통 주) UF_4 에서 UF_6 로의 변환은 연소반응기에서 <u>불</u>	<생략>	0B003.e	(생략) 주) UF_4 에서 UF_6 로의 변환은 연소반응기에서 <u>불소와</u>	<현행과 동일>

	<p><u>소로</u> 발열 반응을 통해 수행된다. <u>UF₆는 유출류가 -10°C로 냉각된 냉각트랩을 통과할 때 발생하는 고온 유출가스로부터 응축된다.</u> 이 공정에는 불화가스가 원료로 사용된다.</p>			<p><u>의</u> 발열 반응을 통해 수행된다. <u>고온의 UF₆ 가스는 -10°C로 냉각된 냉각트랩의 유출류를 통과하며 응축된다.</u> 이 공정에는 불화가스가 원료로 사용된다.</p>	
0B003.g	<p>g. UF₆를 UO₂로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통</p> <p>주) UF₆에서 UO₂로의 변환은 다음 세 가지 공정 중 하나를 통해 수행될 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UF₆는 수소와 증기를 사용하여 UO₂로 환원되고 가수 분해된다. - UF₆는 물에 용해되어 가수 분해되고, <u>암모니아를 첨가하여</u> 중우라늄산 암모늄으로 <u>침전시킨 후, 이를 820°C에서 수소로 환원시켜 UO₂를 제조한다.</u> - 가스 상태의 UF₆, CO₂ 및 NH₃가 물에서 결합되어 암모늄 우라닐 탄 	<생략>	0B003.g	<p>주) UF₆에서 UO₂로의 변환은 다음 세 가지 공정 중 하나를 통해 수행될 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UF₆는 수소와 증기를 사용하여 UO₂로 환원되고 가수 분해된다. - UF₆는 물에 용해되어 가수 분해되고, <u>암모니아가 첨가되어</u> 중우라늄산 암모늄으로 <u>침전된 후, 820°C에서 수소와 반응하여 UO₂로 환원된다.</u> - 가스 상태의 UF₆, CO₂ 및 NH₃가 물에서 결합되어 암모늄 우라닐 탄 	<현행과 동일>

	<p>산염으로 침전된다. 암모늄 우라닐 탄산염은 500 ~ 600°C에서 수증기 및 수소와 결합하여 UO_2가 된다.</p> <p>UF₆에서 UO_2로의 변환은 <u>연료 성형가공 공정의 첫 단계이다.</u></p>			<p>산염으로 침전된다. 암모늄 우라닐 탄산염은 500 ~ 600°C에서 수증기 및 수소와 결합하여 UO_2가 된다.</p> <p>UF₆에서 UO_2로의 변환은 <u>핵연료 가공공장의 첫 단계로 수행되기도 한다.</u></p>	
0B003.i	<p>i. UO_2를 UCl_4로 변환하기 위해 특별히 설계되거나 준비된 계통</p> <p>주) UO_2에서 UCl_4의 변환은 두가지 공정중 하나에 의해 수행된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UO_2는 약 400°C에서 CCl_4와 반응하여 UCl_4로 변환한다. - UO_2는 카본블랙 (CAS 1333-86-4), 탄소 <u>일산화물 및 염소가</u> 함께 있을 때, 약 700°C에서 반응하여 <u>UCl_4를 만들어낸다.</u> 	<p>i. Especially designed or prepared systems for the conversion of UO_2 to UCl_4</p> <p>EXPLANATORY NOTE Conversion of UO_2 to <u>UCl_4</u> can be performed by one of two processes. In the first, UO_2 is reacted with carbon tetrachloride(<u>CCl_4</u>) at approximately 400°C. In the second, UO_2 is reacted at approximately 700°C in the presence of carbon black (CAS 1333-86-4), carbon monoxide, and chlorine to yield <u>UCl_4</u>.</p>	0B003.i	<p>주) UO_2에서 UCl_4의 변환은 두가지 공정중 하나에 의해 수행된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UO_2는 약 400°C에서 CCl_4와 반응하여 UCl_4로 변환한다. - UO_2는 카본블랙 (CAS 1333-86-4), <u>일산화탄소 및 염소와</u> 약 700°C에서 반응하여 <u>UCl_4로 변환된다.</u> 	<p>EXPLANATORY NOTE Conversion of UO_2 to <u>UCl_4</u> can be performed by one of two processes. In the first, UO_2 is reacted with carbon tetrachloride(<u>CCl_4</u>) at approximately 400°C. In the second, UO_2 is reacted at approximately 700°C in the presence of carbon black (CAS 1333-86-4), carbon monoxide, and chlorine to yield <u>UCl_4</u>.</p>
0B005 (NT4)	<p>핵연료 가공공장과 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장</p>	<생략>	0B005 (NT4)	<p>핵연료 가공공장과 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장</p>	<생략>

<p>(NM2.4)</p>	<p>비</p> <p>주) 핵연료(nuclear fuel elements)는 0C001, 0C002에서 정의한 핵연료물질이나 특수 핵분열성 물질중 하나 또는 그 이상의 물질로 제조된 것이다. <u>핵연료공장에는</u> 압분, 소결, 연마 및 검사(grading)장치가 있다. 혼합산화 핵연료는 피복관 내에 봉인될 때까지 글로브 박스(혹은 이와 동등한 용기)내에서 취급된다. 원자로 운전시 적절한 성능과 안전을 위하여 핵연료는 제1차로 피복관 내에 밀봉된다. 또한, 핵연료는 예측 가능하고 안전성을 보증하기 위하여 공정과 절차, 장비 등에 대한 고도의 기술기준의 적용 및 엄격한 관리가 필요하다.</p>		<p>(NM2.4)</p>	<p>비</p> <p>주) 핵연료(nuclear fuel elements)는 0C001, 0C002에서 정의한 핵연료물질이나 특수 핵분열성 물질중 하나 또는 그 이상의 물질로 제조된 것이다. <u>가장 일반적인 핵연료 유형인 산화물 핵연료의 경우에는</u> 압분, 소결, 연마 및 검사(grading)장치가 있다. 혼합산화 핵연료는 피복관 내에 봉인될 때까지 글로브 박스(혹은 이와 동등한 용기)내에서 취급된다. 원자로 운전시 적절한 성능과 안전을 위하여 핵연료는 제1차로 피복관 내에 밀봉된다. 또한, 핵연료는 예측 가능하고 안전성을 보증하기 위하여 공정과 절차, 장비 등에 대한 고도의 기술기준의 적용 및 엄격한 관리가 필요하다.</p>	
----------------	--	--	----------------	--	--

	<p><u>핵연료</u> 가공을 위해 "특별히 설계 또는 준비된 장비"의 의미와 부합하는 것으로 간주되는 장비는 다음을 포함한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵물질의 생산 공정과 직접 접하거나, 직접 가공 또는 제어하는 장비 - 피복재 내에 핵물질을 밀봉하는 장비 - 피복 또는 밀봉 상태를 검사하는 장비 - 밀봉된 핵연료의 마무리를 검사하는 장비 - 원자로 핵연료를 조립하는 장비 <p>주) 위의 장비, 계통이나 장치는 다음과 같은 것들을 포함한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵연료 소결체의 최종 크기와 표면 결함을 검사하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 완전히 자동화된 소결체 검사기 - 핵연료 핀(또는 봉) 말 			<p><u>주) 핵연료</u> 가공을 위해 "특별히 설계 또는 준비된 장비"의 의미와 부합하는 것으로 간주되는 장비는 다음을 포함한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 핵물질의 생산 공정과 직접 접하거나, 직접 가공 또는 제어하는 장비 b. 피복재 내에 핵물질을 밀봉하는 장비 c. 피복 또는 밀봉 상태를 검사하는 장비 d. 밀봉된 핵연료의 마무리를 검사하는 장비 e. 원자로 핵연료를 조립하는 장비 <p>주) 위의 장비, 계통이나 장치는 다음과 같은 것들을 포함한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 핵연료 소결체의 최종 크기와 표면 결함을 검사하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 완전히 자동화된 소결체 검사기 2) 핵연료 핀(또는 봉) 말 	
--	--	--	--	--	--

	<p>단의 마개를 용접하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 자동 용접기</p> <p>- 완성된 핵연료핀(또는 봉)의 건전성을 검사하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 자동 시험 및 검사기</p> <p>- <u>핵연료 피복관을 제조하기 위해 특별히 설계 혹은 준비된 시스템으로서 일반적으로 다음의 장비를 포함한다.</u></p> <p style="text-align: center;"><추가></p> <p>a) 핀(또는 봉)의 말단 마개 용접의 X선 시험 장비</p> <p>b) 가압된 핀(또는 봉)으로부터의 헬륨 누출 감시 장비</p> <p>c) 핀(또는 봉) 내부 핵연료 소결체 장전의 정확성을 검사하기 위한 감마선 조사 장비</p>	<p><u>Item 3 typically includes equipment for:</u>a) <u>x-ray examination of pin (or rod) end cap welds,</u></p> <p>b) <u>helium leak detection from pressurized pins (or rods), and c) gamma-ray scanning of the pins (or rods) to check for correct loading of the fuel pellets inside.</u></p>		<p>단의 마개를 용접하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 자동 용접기</p> <p>3) 완성된 핵연료핀(또는 봉)의 건전성을 검사하기 위해 특별히 설계 또는 준비된 자동 시험 및 검사기</p> <p>4) <u>핵연료 피복관을 제조하기 위해 특별히 설계 혹은 준비된 시스템</u></p> <p>품목3)은 일반적으로 아래 장비를 포함한다.</p> <p>a) 핀(또는 봉)의 말단 마개 용접의 X선 시험 장비</p> <p>b) 가압된 핀(또는 봉)으로부터의 헬륨 누출 감시 장비</p> <p>c) 핀(또는 봉) 내부 핵연료 소결체 장전의 정확성을 검사하기 위한 감마선 조사 장비</p>	<p><u>Item 3 typically includes equipment for:</u></p> <p>(a) <u>X-ray examination of pin (or rod) end cap welds;</u></p> <p>(b) <u>Helium leak detection from pressurized pins (or rods);</u></p> <p>(c) <u>Gamma-ray scanning of the pins (or rods) to check for correct loading of the fuel</u></p>
--	---	---	--	--	--

<p>0B006.e</p>	<p>e. 화학약품 취급용기 또는 저장조</p> <p>재처리공장에서 사용되는 화학약품을 취급하기 위해 특별히 설계된 시설 또는 저장조로서 질산에 대한 내부식성을 갖고, 저탄소 스테인레스강, 티타늄이나 지르코늄, 또는 다른 우수한 재질로 제작되고, 원격조작으로 유지보수를 할 수 있도록 설계되고, 핵임계 제어를 위해 다음의 특성을 갖는 것</p> <p>1) 최소한 2%의 붕소 등가(치)를 갖는 벽 또는 내부 구조물, 또는</p> <p>2) 직경이 175mm이하인 실린더형 용기 또는</p> <p>3) 최대폭이 75mm이하 판상형(slab) 또는 환상(annular)형 용기</p> <p>주) 용매추출 단계에는 다</p>	<p><생략></p>	<p>0B006.e</p>	<p>e. 화학약품 취급용기 또는 저장조</p> <p>조사후 핵연료 재처리공장에서 사용되는 화학약품을 취급하기 위해 특별히 설계된 시설 또는 저장조로서 질산에 대한 내부식성을 갖고, 저탄소 스테인레스강, 티타늄이나 지르코늄, 또는 다른 우수한 재질로 제작되고, 원격조작으로 유지보수를 할 수 있도록 설계되고, 핵임계 제어를 위해 다음의 특성을 갖는 것</p> <p>(1) 최소한 2%의 붕소 등가(치)를 갖는 벽 또는 내부 구조물, 또는</p> <p>(2) 직경이 175mm(7in)이하인 실린더형 용기 또는</p> <p>(3) 최대폭이 75mm(3in)이하 판상형(slab) 또는 환상(annular)형 용기</p> <p>주) 용매추출 단계에는 세</p>	<p>pellets inside</p> <p><현행과 동일></p>
----------------	--	-------------------	----------------	---	---

	<p><u>음과 같은 세 가지 주요 액체 공정</u>이 있으며, 화학약품 취급용기 또는 저장 용기는 아래와 같은 세 가지의 <u>추가가공 공정</u>에서 이용된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 순수 질산우라늄 용액은 증발 <u>농축시킨 후, 질산제거 공정 (산화우라늄으로 변환)으로 이송되고, 이 산화우라늄은 핵연료주기에 재이용된다.</u> - <u>강력한 방사성 핵분열 생성물 용액은 증발 농축시켜 농축 용액으로 저장하며, 또한 이 농축물을 저장이나 처분에 알맞은 형태로 변환하기 위하여 계속 증발시킨다.</u> - 순수 질산플루토늄 용액은 <u>농축시켜</u> 다음 단계로 이송하기 전까지 <u>저장하고,</u> 특히 <u>플루토늄용액 저장조는</u> 용액의 농도와 형태의 변화 			<p><u>가지 주요 액체 공정(공제염, 우라늄-플루토늄 상호분리, 정제)</u>이 있으며, 화학약품 취급용기 또는 저장 용기는 아래와 같은 세 가지의 <u>부속공정</u>에서 이용된다.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 순수 질산우라늄 용액은 증발 <u>농축 후 산화우라늄으로 변환되는 탈질 공정으로 이송된다.</u> 산화우라늄은 핵연료 주기에서 재사용된다. (b) <u>고방사성 핵분열생성물 용액은 증발 농축하여 농축 용액으로 저장된다.</u> 이 농축 용액은 저장이나 처분에 적절한 형태로 변환하기 위하여 계속 증발된다. (c) 순수 질산플루토늄 용액은 <u>농축 후</u> 다음 단계로 이송하기 전까지 <u>저장한다.</u> 특히 <u>플루토늄 용액의 취급용기나 저장조는</u> 용액의 	
--	---	--	--	--	--

	로 인한 핵임계를 차단할 수 있도록 설계되어야 한다.			농도와 형태의 변화로 인한 핵임계를 차단할 수 있도록 설계되어야 한다.	
0C	<p>물질 핵원료물질 및 특수 핵분열성 물질 국제원자력기구(IAEA) 현장 제20조에 정의된 물질들을 의 미한다. ※ <u>원자력법</u>에 명시된 핵원 료물질 및 핵연료물질의 정의와는 다르게 적용한 다.</p>	<생략>	0C	<p>물질 핵원료물질 및 특수 핵분열성 물질 국제원자력기구(IAEA) 현장 제20조에 정의된 물질들을 의 미한다. ※ <u>원자력안전법</u>에 명시된 핵 원료물질 및 핵연료물질 의 정의와는 다르게 적용 한다.</p>	<현행과 같음>
0C003 (NT2.1)	<p>중수소 및 중수 0A001.a에서 정의된 원자로 에 사용되는 <u>중수소·중수</u> 또 는 중수소화합물(중수소대 수소의 원자비가 1 : 5,000을 초과 하는 것) <u>주) 연력 1년(1월1일부터 12월 31일) 동안 단 일 국가에 대한 중수 소 총 수출량이 200kg 이하인 경우에 는 통제하지 않는다.</u></p>	<p>Deuterium and heavy water <u>Deuterium heavy water</u> (deuterium oxide) and any other deuterium compound in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000 for use in a nuclear reactor as defined in paragraph 0A001.a above in quantities exceeding 200kg of deuterium atoms for any one recipient country within a period of one calendar year(1 Jan-31</p>	0C003 (NT2.1)	<p>중수소 및 중수 0A001.a에서 정의된 원자로 에 사용되는 <u>중수소 또는 중수</u> 또는 중수소화합물(중 수소대 수소의 원자비가 1 : 5,000을 초과 하는 것)<u>으로 서, 연력 1년(1월1일부터 12 월 31일) 동안 단일 국가에 대한 중수소 원자의 총 수 출량이 200kg를 초과하는 것</u></p>	Deuterium and heavy water <u>Deuterium, heavy water</u> (deuterium oxide) and any other deuterium compound in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000 for use in a nuclear reactor as defined in paragraph 0A001.a above in quantities exceeding 200kg of deuterium atoms for any one recipient country within a period of one calendar year(1 Jan-31

<p>0C004 (NT2.2)</p>	<p>원자로급 흑연 0A001.a에서 정의한 원자로에 사용되는 흑연으로서 <u>5ppm 보다 높은 순도와, 밀도 1.50g/cm³, 1kg 을 초과하는 것</u></p> <p>주) 수출통제를 목적으로 할 경우, 여기서 정의된 사양의 흑연 수출이 원자로에 사용될 것인지의 여부는 수출국 정부가 결정한다. <u>0A001.a에 정의된 원자로에서 사용하지 않는 흑연으로서 5ppm (parts per million) 보다 높은 순도와, 밀도 1.50g/cm³을 초과하는 것은 통제하지 않는다.</u></p> <p>붕소 <u>환산식은 INFCIRC/254/Part 1을 따른다.</u></p>	<p>Dec). <생략></p>	<p>0C004 (NT2.2)</p>	<p>원자로급 흑연 0A001.a에서 정의한 원자로에 사용되는 흑연으로서 <u>붕소 등가치가 5ppm 미만의 양질의 순도와 밀도 1.50g/cm³, 1kg 을 초과하는 것</u></p> <p>주) 수출통제를 목적으로 할 경우, 여기서 정의된 사양의 흑연 수출이 원자로에 사용될 것인지의 여부는 수출국 정부가 결정한다. <u>붕소 등가치가 5ppm 미만의 양질의 순도와 밀도 1.50g/cm³, 1kg 을 초과하는 것임에도 원자로에 사용하지 않는 흑연은 통제하지 않는다.</u></p> <p>붕소 <u>등가치(BE)는 실험적으로 결정되거나 붕소를 포함한 불순물의 BE₂의 합으로 아래식에 따라 계산된다. (탄소는 불순물로 간주되지 않으므로 BE₂에서 제외)</u></p>	<p>Dec). <현행과 같음></p>
--------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	--	--------------------------------------

	$BE_z(\text{ppm}) = CF \times Z$ 원소의 농도(in ppm); CF 는 변환계수: $(\sigma_z \times AB) / (\sigma_B \times A_z)$; σ_B : 자연발생 붕소의 열중성자 흡수반응단면적(단위: barns) σ_z : Z원소의 열중성자 흡수반응단면적(단위: barns) AB 와 A_z 은 붕소와 Z원소 각각의 원자질량이다.			$BE_z(\text{ppm}) = CF \times Z$ 원소의 농도(in ppm); CF 는 변환계수: $(\sigma_z \times A_B) / (\sigma_B \times A_z)$; σ_B : 자연발생 붕소의 열중성자 흡수반응단면적(단위: barns) σ_z : Z원소의 열중성자 흡수반응단면적(단위: barns) A_B 와 A_z 은 붕소와 Z원소 각각의 원자질량이다.	
0D	소프트웨어	<생략>	0D	0D001 소프트웨어	<현행과 같음>
부록 - 민감품목 Sensitive List					
9B001	가스터빈 블레이드, 베인 (vanes) 또는 "팁 슈라우드(shroud)"의 제작을 위해 전용 설계된 장비, 공구 및 고정구로서 다음의 것 a. 방향성 고형화나 단결정화에 의한 주조장비 b. 내화 금속 또는 세라믹으로부터 제작된 주조 공구로서 다음의 것: 1. 심층부(cores); 2. 주형(moulds);	Equipment, tooling or fixtures, specially designed for manufacturing gas turbine engine blades, vanes or "tip shrouds", as follows: a. Directional-solidification or single-crystal casting equipment; b. Casting tooling, manufactured from refractory metals or ceramics, as follows: 1. Cores; 2. Shells (moulds);	9B001	제조 장비, 공구 및 고정구로서 다음의 것: a. 방향성 고형화나 단결정화에 의한 주조장비 b. 내화 금속 또는 세라믹으로부터 제작된 주조 공구로서 다음의 것: 1. 심층부(cores); 2. 주형(moulds);	Manufacturing equipment, tooling or fixtures, as follows: a. Directional-solidification or single-crystal casting equipment; b. Casting tooling, manufactured from refractory metals or ceramics, as follows: 1. Cores; 2. Shells (moulds);

	3. 심층부와 주형이 결합된 유닛; c. 방향성 고형화 ...	3. Combined core and shell (mould) units; c. Directional-solidification...		3. 심층부와 주형이 결합된 유닛; c. 방향성 고형화 ...	3. Combined core and shell (mould) units; c. Directional-solidification...
본 리스트에 사용된 용어의 정의 DEFINITIONS OF TERMS USED IN THESE LISTS					
CAT 6	<생략>	"Compensation systems" (6) consist of the primary scalar sensor, one or more reference sensors (e.g., vector "magnetometers") together with software that permit reduction of <u>rigid body</u> rotation noise of the platform.	CAT 6	<현행과 같음>	"Compensation systems" (6) consist of the primary scalar sensor, one or more reference sensors (e.g., vector "magnetometers") together with software that permit reduction of <u>the rigid body</u> rotation noise of the platform.
CAT <u>1, 2, 9</u>	"확산 결합"(1 2 9)는 계면에 서 일어나는 원자의 상호확산 기구를 이용하여, 적어도 두개의 개별금속을 하나의 몸체로 만드는 고상결합으로, 계면에서의 결합강도는 가장 약한 금속의 결합강도와 같은 값을 가진다.	"Diffusion bonding" (1 2 9) means a solid state joining of at least two separate pieces of metals into a single piece with a joint strength equivalent to that of the weakest material, wherein the principal mechanism is interdiffusion of atoms across the interface.	CAT <u>1, 2, 9</u>	"확산 결합"(1 2-9)는 계면에 서 일어나는 원자의 상호확산 기구를 이용하여, 적어도 두개의 개별금속을 하나의 몸체로 만드는 고상결합으로, 계면에서의 결합강도는 가장 약한 금속의 결합강도와 같은 값을 가진다.	"Diffusion bonding" (1 2 9) means a solid state joining of at least two separate pieces of metals into a single piece with a joint strength equivalent to that of the weakest material, wherein the principal mechanism is interdiffusion of atoms across the interface.
<신설>	<신설>	<신설>	<u>CAT 3</u>	<u>"게이트올라운드 전계 효과 트랜지스터"("GAARET")(3)는 모든 반도체 전도 채널 요소들을 둘러싸고 전류를 제어하는 공통 게이트 구조를 가진 단일 또는 다중 반도체 전도 채널 요소를 가진 장치</u>	<u>"Gate-All-Around Field-Effect Transistor" ("GAAFET")(3) means a device having a single or multiple semiconductor conduction channel element(s) with a common gate structure that surrounds and controls current in all of the</u>

				<u>주: 본 정의는 나노시트 (nanosheet) 또는 나노와이어(nanowire) 전계효과 및 주변 게이트 트랜지스터 그리고 기타 "GAAFET" 반도체 채널 요소 구조를 포함한다.</u>	<u>semiconductor conduction channel elements.</u> <u>Note: This definition includes nanosheet or nanowire field-effect and surrounding gate transistors and other "GAAFET" semiconductor channel element structures.</u>
CAT <u>2, 6</u>	"프로그램" (<u>2, 6</u>)은 프로세스를 수행하기 위해서, 컴퓨터로 실행할 수 있거나 실행할 수 있는 형태로 변환 가능한 일련의 명령어들을 의미한다.	"Program" (<u>2, 6</u>) means a sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.	CAT <u>2,6</u>	"프로그램" (<u>2-6</u>)은 프로세스를 수행하기 위해서, 컴퓨터로 실행할 수 있거나 실행할 수 있는 형태로 변환 가능한 일련의 명령어들을 의미한다.	"Program" (<u>2-6</u>) means a sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.